

(TRANSLATION)



Ref.: No. EI-0017 Dispatch No. 107901 Mailing Date: Mar. 29, 2005

#### NOTICE OF REASON FOR REJECTION

Patent Application No. 9-206591

Drafted Date: March 22, 2005

Patent Office Examiner: Kohichi KATOH

Attorneys of the Applicant: Tsutomu TOYAMA, et al (1 other)

Applied Provisions of Patent Law: Article 29, Paragraph 1

Article 29, Paragraph 2

Article 29-bis

Article 36

This application is to be rejected by the following reasons. If the applicant has any arguments, such arguments should be filed within 60 days from the mailing date of this Notice.

#### REASONS

I. The inventions of the below listed claims of this application are unpatentable under Article 29, Paragraph 1, Item (iii) of Patent Law, as the inventions are described in the below listed publications which were distributed in Japan or foreign countries, prior to filing of this application.

Notes (see the List of Cited Documents)

Claims 1-2, 4-5:

Cited Documents: 1-3

#### Remarks:

Regarding Claims 1-2 and 4-5:

See the Cited Document 1: page 3, upper right column, lines 9-10, lower left column, lines 13-16; page 4, upper left column, lines 14-15; and FIG. 1.

See the Cited Document 3: page 2, lower left column, line 5 to upper right column, line 6; page 3, upper left column, lines 1-18; FIG. 1; and FIG. 2.

Regarding Claims 1 and 4:

See the Cited Document 2: the description of paragraphs [0021]-[0025]; FIG. 1; and FIG. 2.

**II.** The inventions of the below-listed claims of this application are unpatentable under Article 29, Paragraph 2 of Patent Law, as the inventions could have been easily made by one of ordinary skill in this art based on the inventions described in the below-listed publications which were distributed in Japan or foreign countries, prior to the filing of this application.

Notes (see the List of Cited Documents)

Claims 1-5:

Cited Documents: 1-3 and 5

Remarks:

Regarding Claims 1-2 and 4-5:

See the Cited Document 1: page 3, upper right column, lines 9-10, lower left column, lines 13-16; page 4, upper left column, lines 14-15; and FIG. 1.

See the Cited Document 3: page 2, lower left column, line 5 - lower right column, line 6; page 3, upper left column, lines 1-18; FIG. 1; and FIG. 2.

Regarding Claims 1 and 4:

See the Cited Document 2: the description of paragraphs [0021]-[0025]; FIG. 1; and FIG. 2.

Regarding Claim 3:

Removing means for removing the insulating material layer 23 as exemplified in paragraph [0024] of the Cited Document 2 is etching

back by anisotropic etching, and, in this respect, the invention of the Cited Document 2 and the invention of Claim 3 of the present application are different. However, the CMP method as the layer removing means is a well-known method (for example, see paragraph [0022] of the Cited Document 5), and, therefore, use of the well-known CMP method in the invention of the Cited Document 2 could have been made suitably by one of ordinary skill in this art.

**III.** The inventions of the below-listed claims of this application are unpatentable under Article 29-bis of Patent Law, as the inventions are identical with the invention disclosed in the specification or drawings attached to the original request of the below-listed patent application which was filed prior to the filing date of the present application and which was laid-open after filing of the present application, and, further, the inventor of the present application is not the same as the inventor of said prior patent application, nor the applicant of the present application is the same as the applicant of said prior patent application.

Notes (see the List of Cited Documents)

Claims: 1 and 3-5

Cited Document: 4

Remarks:

See the Cited Prior Patent Application 4, specifically the description of paragraphs [0089] - [0095]; FIG. 12; and FIG. 13.

List of Cited Documents

1. Japanese Patent Laid-Open Publication No. Hei 02-257637
2. Japanese Patent Laid-Open Publication No. Hei 07-307383
3. Japanese Patent Laid-Open Publication No. Sho 63-255938
4. Japanese Patent Application No. Hei 08-225613  
(Japanese Patent Laid-Open Publication No. Hei 10-070116)
5. Japanese Patent Laid-Open Publication No. Hei 06-045432

IV. This application does not meet the requirements of Article 36, Paragraph 6, Item 2, of the Patent Law in respect of the following points in the below mentioned claims.

Notes

The recitation of "selectively removable material capable of establishing a condition under which said oxidation proof layer is selectively removed" in Claim 1 and the recitation of "selectively removable material capable of establishing a condition under which a silicon nitride layer is selectively removed" in Claim 4 are unclear. (Regarding the "material", the specification does not expressly indicate a criterion for uniquely determining what kind of material is included, or not included at all, in the "material"). Therefore, Claims 1 and 4 are indefinite.

/ / / / / / / LAST ITEM / / / / / / /

## 拒絕理由通知書

特許出願の番号 平成 9年 特許願 第206591号  
起案日 平成17年 3月22日  
特許庁審査官 加藤 浩一 8617 4M00  
特許出願人代理人 遠山 勉 (外 1名) 様  
適用条文 第29条第1項、第29条第2項、第29条の2  
、第36条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から 60 日以内に意見書を提出して下さい。

理由

I. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 1-2、4-5
- ・引用文献等 1-3

• 備考

- ・請求項1-2、4-5について
- ・引例1の第3頁右上欄第9-10行、左下欄第13-16行、第4頁左上欄第14-15行、第1図等の記載を参照されたい。
- ・引例3の第2頁左下欄第5行-右下欄第6行、第3頁左上欄第1-18行、第1図、第2図等の記載を参照されたい。

- ・請求項1、4について
- ・引例2の【0021】-【0025】、図1、図2等の記載を参照されたい。

ない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 1-5
- ・引用文献等 1-3、5

・備考

- ・請求項1-2、4-5について
- ・引例1の第3頁右上欄第9-10行、左下欄第13-16行、第4頁左上欄第14-15行、第1図等の記載を参照されたい。
- ・引例3の第2頁左下欄第5行-右下欄第6行、第3頁左上欄第1-18行、第1図、第2図等の記載を参照されたい。

- ・請求項1、4について
- ・引例2の【0021】-【0025】、図1、図2等の記載を参照されたい。

・請求項3について

引例2の【0024】に例示された絶縁材層23の除去手段は、異方性エッチングによるエッチバックであり、この点で、引例2の発明と本願の請求項3に係る発明は相違するが、膜除去手段としてのCMPは周知（例えば、引例5の【0022】）の方法であるから、引例2に記載された発明において、前記周知のCMPを用いることは当業者が適宜なし得たことである。

III. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に出願公開がされた下記の特許出願の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時に、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 1、3-4
- ・引用文献等 4

・備考

先願明細書4の【0089】-【0095】、図12、図13等の記載を参照されたい。

## 引用文献等一覧

1. 特開平02-257637号公報
2. 特開平07-307383号公報
3. 特開昭63-255938号公報
4. 特願平08-225613号(特開平10-070116号公報)
5. 特開平06-045432号公報

IV. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

## 記

請求項1の「前記耐酸化性膜が選択的に除去される条件が成り立つ選択除去可能材料」、及び、請求項4の「シリコン塗化膜が選択的に除去される条件が成り立つ選択除去可能材料」は、不明瞭な記載である。(どのような材料が前記「材料」に含まれ、あるいは含まれないのかを一義的に判断する基準が明細書中に明確に示されていない。よって、請求項1、4に係る発明は明確でない。

## 先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 I P C 第7版 H 0 1 L 2 1 / 9 4

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、または面接のご希望がございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第三部半導体機器 加藤 浩一

TEL. (03)3581-1101 内線3462  
FAX. (03)3501-0673